

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2010年3月4日(04.03.2010)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2010/023860 A1

- (51) 国際特許分類:  
*H01M 14/00* (2006.01) *H01L 31/04* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2009/004047
- (22) 国際出願日: 2009年8月24日(24.08.2009)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願 2008-221170 2008年8月29日(29.08.2008) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 新日鐵化学株式会社(Nippon Steel Chemical Co.,Ltd.) [JP/JP]; 〒1010021 東京都千代田区外神田4-1-4 Tokyo (JP). 国立大学法人九州工業大学(National University Corporation Kyushu Institute of Technology) [JP/JP]; 〒8048550 福岡県北九州市戸畑区仙水町1番1号 Fukuoka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 山口能弘(YAMAGUCHI, Yoshihiro) [JP/JP]; 〒8048503 福岡県北九州市戸畑区大字中原先の浜46番地の80新日鐵化学株式会社内 Fukuoka (JP). 早瀬修二(HAYASE, Shuzi) [JP/JP]; 〒8048550 福岡県北九州市戸畑区仙水町1番1号国立大学法人九州工業大学内 Fukuoka (JP).
- (74) 代理人: 内田勝(UCHIDA, Masaru); 〒1670043 東京都杉並区上荻1丁目24-18 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 規則 4.17 に規定する申立て:  
— 発明者である旨の申立て (規則 4.17(iv))
- 添付公開書類:  
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: DYE-SENSITIZED SOLAR CELL AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME

(54) 発明の名称: 色素増感太陽電池およびその製造方法

(57) Abstract: Provided are a dye-sensitized solar cell wherein power extraction efficiency is greatly improved, and a method for manufacturing the dye-sensitized solar cell. The dye-sensitized solar cell is provided with a substrate, a porous semiconductor layer having a dye adsorbed therein, a conductive metal layer, and a conductive substrate. The conductive metal layer (16) is a power collecting section arranged on the porous semiconductor layer side opposite to the side where the substrate is arranged. The conductive metal layer (16) is composed of the conductive metal section (17) composed of a mesh member, and a covered section (19) covered with the conductive metal section (17). The covered section (19) is composed of an inner layer (19a) and an outer layer (19b), and has a gradient composition structure wherein oxidation degree increases toward the porous semiconductor layer (14) from the conductive metal section (17). Thus, the covered section (19) has the gradient composition structure wherein thermal expansion coefficient reduces toward the porous semiconductor layer (14) from the conductive metal section (17).

(57) 要約: 電力取り出し効率の大幅な向上を図ることができる色素増感太陽電池およびその製造方法を提供する。色素増感太陽電池は、基板と、色素を吸着した多孔質半導体層と、導電性金属層と、導電性基板を備える。導電性金属層16は、多孔質半導体層の基板が設けられる側とは反対側に配置される集電部である。導電性金属層16は、メッシュ部材からなる導電性金属部17と、導電性金属部17に被覆される被覆部19で構成される。被覆部19は、内層19aと外層19bで構成され、導電性金属部17の側から多孔質半導体層14の側に向けて酸化度が高くなる傾斜組成構造を有する。これにより、被覆部19は、導電性金属部17の側から多孔質半導体層14の側に向けて熱膨張率が低くなる傾斜組成構造を有する。



WO 2010/023860 A1

## 明 細 書

**発明の名称**：色素増感太陽電池およびその製造方法

### 技術分野

[0001] 本発明は、色素増感太陽電池およびその製造方法に関する。

### 背景技術

[0002] 色素増感太陽電池は、湿式太陽電池あるいはグレッツェル電池等と呼ばれ、シリコン半導体を用いることなくヨウ素溶液に代表される電気化学的なセル構造を持つ点に特徴がある。具体的には、透明な導電性ガラス板（透明導電膜を積層した透明基板）に二酸化チタン粉末等を焼付け、これに色素を吸着させて形成したチタニア層等の多孔質半導体層と導電性ガラス板（導電性基板）からなる対極の間に電解液としてヨウ素溶液等を配置した、簡易な構造を有する。透明な導電性ガラス板の側から色素増感太陽電池セル内に導入される太陽光が色素に吸収されることで電子が発生する。

色素増感太陽電池は、材料が安価であり、作製に大掛かりな設備を必要としないことから、低コストの太陽電池として注目されている。

[0003] 色素増感太陽電池は、太陽光の変換効率のさらなる向上が求められており、種々の観点から検討がなされている。

そのうちのひとつとして、電極の導電性の改善による電力取り出し効率の向上を図るために、光入射側に設けられる透明基板上に通常形成される透明導電膜を省略すること等が検討されている。電極の導電性の改善は、太陽電池を大型化する際に特に大きな意義を持つ。

[0004] このような技術として、例えば、ガラス基板上に、半導体微粒子層、金属網、電荷移動層および対極をこの順番で含む積層部を有する構造の光電変換素子が開示されている（特許文献1、2参照）。

また、例えば、基材上に、透明導電膜と、透明導電膜よりも抵抗値の低い金属または合金よりなるメッシュ状の導電体を設けることで電極の低抵抗化を図るとともに、さらに、メッシュ状の導電体が酸化することによって生じ

る抵抗値の増加を防ぐために、メッシュ状の導電体の表面に不働態膜を形成し、さらにはその上に半導体膜等の膜を形成した色素増感太陽電池用電極が開示されている（特許文献3参照）。

[0005] また、例えば、透明基板上にSUSを集電電極として設け、SUSの上にインシュレーターとして汎用されるSiO<sub>x</sub>膜を、およびSiO<sub>x</sub>膜の上にITOを、それぞれスパッタリングしたSUS電極を有する色素増感太陽電池が開示されている（非特許文献1参照）。この太陽電池の太陽光の変換効率は4.2%と報告されている。

[0006] なお、対極を導電性透明基板で形成し、対極側から色素増感太陽電池セル内に光を導入する種々の技術が開示されている（例えば特許文献4参照）。

### 先行技術文献

#### 特許文献

- [0007] 特許文献1：特開2001-283941号公報  
特許文献2：特開2007-73505号公報  
特許文献3：特開2005-197176号公報  
特許文献4：特許2664194号公報

#### 非特許文献

- [0008] 非特許文献1：Kang-Jin Kim, et al., A4.2% efficient flexible dye-sensitized TiO<sub>2</sub> solar cells using stainlesssteel substrate, Solar Energy Materials & Solar Cells 90 (2006) 574-581

### 発明の概要

#### 発明が解決しようとする課題

- [0009] しかしながら、上記した従来技術は、いずれも、電力取り出し効率の一層の向上を図るためにはさらなる改善が必要である。
- [0010] 本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、電力取り出し効率の一層の向上を図ることができる色素増感太陽電池およびその製造方法を提供することを目的とする。

## 課題を解決するための手段

[0011] 本発明に係る色素増感太陽電池は、基板と、カソード極となる導電性基板と、該基板と該導電性基板の間に、該基板に近接してまたは接触して配置され色素を吸着した多孔質半導体層と、該多孔質半導体層と接触して配置されアノード極となる導電性金属層を備え、該基板および該導電性基板のうちの少なくともいずれか一方が透明基板であり、電解質が封止されてなる色素増感太陽電池であって、

該導電性金属層が、導電性金属部と、該導電性金属部の少なくとも該多孔質半導体層と接触する側に被覆される被覆部で構成され、

該被覆部が、該導電性金属部の側から該多孔質半導体層の側に向けて熱膨張率が低くなる傾斜組成構造を有することを特徴とする。

[0012] また、本発明に係る色素増感太陽電池は、好ましくは、前記被覆部が、前記導電性金属部の側から前記多孔質半導体層の側に向けて酸化度が高くなる傾斜組成構造を有することを特徴とする。

[0013] また、本発明に係る色素増感太陽電池は、好ましくは、前記被覆部が、Ti、W、Ni、PtおよびAuからなる群から選ばれる1種または2種以上の耐食性金属材料の酸化物で形成されてなることを特徴とする。

[0014] また、本発明に係る色素増感太陽電池は、好ましくは、前記導電性金属層が、前記多孔質半導体層の前記基板が設けられる側とは反対側に配置される集電部であり、該多孔質半導体層に前記電解質が自在に流通するための無数の孔が前記導電性金属部に形成されてなるとともに、外部電極に電氣的に接続されてなり、前記基板が透明基板であることを特徴とする。

[0015] また、本発明に係る色素増感太陽電池は、好ましくは、前記導電性金属層の前記導電性金属部がメッシュ部材であることを特徴とする。

[0016] また、本発明に係る色素増感太陽電池は、好ましくは、前記導電性金属層が、前記基板の表面に設けられる集電部であり、該基板に接する側に前記導電性金属部が設けられおよび該導電性金属部を被覆して前記被覆部が設けられるとともに、前記導電性基板が透明基板であることを特徴とする。

[0017] また、本発明に係る色素増感太陽電池は、上記の色素増感太陽電池の製造方法であって、

予め形成した導電性金属部に被覆部を被覆形成する工程において、O、N、S、P、BおよびCからなる群から選ばれる1種または2種以上の元素を含む化合物を少量導入しながら薄膜技術により導電性金属被覆の原料金属を成膜することにより傾斜組成構造を形成することを特徴とする。

[0018] また、本発明に係る色素増感太陽電池は、上記の色素増感太陽電池の製造方法であって、

予め形成した導電性金属部に被覆部を被覆形成する工程において、スパッタ法によりスパッタ層を形成する段階と該スパッタ層の表面に真空蒸着法により蒸着層を形成する段階を含むことにより傾斜組成構造を形成することを特徴とする。

[0019] また、本発明に係る色素増感太陽電池は、好ましくは、前記真空蒸着法が、アークプラズマ蒸着法または真空アーク蒸着法であることを特徴とする。

[0020] また、本発明に係る色素増感太陽電池は、好ましくは、前記被覆部が、前記導電性金属部の側から前記多孔質半導体層の側に向けて熱膨張率が低くなる2以上の異種材料の積層構造であることを特徴とする。

### 発明の効果

[0021] 本発明に係る色素増感太陽電池は、多孔質半導体層と接触して配置されアノード極となる導電性金属層が、導電性金属部と、導電性金属部の少なくとも多孔質半導体層と接触する側に被覆される被覆部で構成され、被覆部が、導電性金属部の側から多孔質半導体層の側に向けて熱膨張率が低くなる傾斜組成構造を有するため、高い電力取り出し効率を得ることができる。

また、本発明に係る色素増感太陽電池の製造方法は、予め形成した導電性金属部に被覆部を被覆形成する工程において、O、N、S、P、BおよびCからなる群から選ばれる1種または2種以上の元素を含む化合物を少量導入しながら薄膜技術により成膜することにより傾斜組成構造を形成するため、本発明に係る色素増感太陽電池を好適に得ることができる。

## 図面の簡単な説明

- [0022] [図1]本実施の形態の第一の例に係る色素増感太陽電池の断面構造の模式図である。
- [図2]メッシュ部材で形成される導電性金属部と、導電性金属部に被覆される被覆部で構成される導電性金属層を説明するための図である。
- [図3]予め孔あけ加工したシート状の導電性金属部と、導電性金属部に被覆される被覆部で構成される導電性金属層を説明するための図である。
- [図4]本実施の形態の第二の例に係る色素増感太陽電池の断面構造の模式図である。
- [図5]本実施の形態の色素増感太陽電池の製造方法の一例を説明するための図である。
- [図6]本実施の形態の色素増感太陽電池の製造方法の他の一例を説明するための図である。
- [図7]色素増感太陽電池の作製方法を説明するための図である。
- [図8]被覆部となる層のSEM表面観察結果を示す図であり、(a)は従来技術の塗布法により、(b)は本実施の形態のスパッタ法により、(c)は本実施の形態のアークプラズマ蒸着法により、それぞれ成膜したものである。

## 発明を実施するための形態

- [0023] 本発明に係る色素増感太陽電池およびその製造方法の好適な実施の形態について、図を参照して、以下に説明する。
- [0024] 本発明者らは、前記した従来色素増感太陽電池の電力取り出し効率が低い原因について種々検討した。

従来技術は、透明導電膜に代えて酸化腐食防止用の保護膜等を被覆した低抵抗な導電性金属にチタニアペーストを塗布し、その後焼結を行う場合に、例えば、熱膨張率（線膨張率、線膨張係数）が $16 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ 程度のステンレス材を導電性金属として用いる。このとき、導電性金属と熱膨張率が $5 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ 程度のチタニア焼成層との熱膨張の差が大きいため、チタニア焼成時の加熱時や冷却時に熱膨張率の違いにより生じる導電性金属とチタ

ニア焼成層の膨張率差および収縮率の違いから導電性金属とチタニア焼成層の間に生じるせん断力によって、保護膜等に部分的な剥離が生じて保護膜等の効果が損なわれ、光电変換効率が十分に得られないおそれがあることに思い至った。

そして、上記の不具合を改善するために、保護膜等に相当するものについて、導電性金属に近い側を導電性金属の熱膨張率に近い材料で形成するとともにチタニア焼成層に近い側をチタニア焼成層の熱膨張率に近い材料で形成することに想達した。

[0025] すなわち、本実施の形態に係る色素増感太陽電池の基本原理は、以下のとおりである。

色素増感太陽電池は、基板と、カソード極となる導電性基板と、基板と導電性基板の間に、基板に近接してまたは接触して配置され色素を吸着した多孔質半導体層と、多孔質半導体層と接触して配置されアノード極となる導電性金属層を備える。基板および導電性基板のうちの少なくともいずれか一方は透明基板であり、色素増感太陽電池には電解質が封止される。

導電性金属層は、導電性金属部と、導電性金属部の少なくとも多孔質半導体層と接触する側に被覆される被覆部で構成される。被覆部は、導電性金属部の側から多孔質半導体層の側に向けて熱膨張率が低くなる傾斜組成構造を有する。

上記の構成により、導電性金属部と多孔質半導体層（チタニア焼成層）の膨張率差および収縮率の違いから導電性金属部とチタニア焼成層の間にせん断力を生じても、被覆部に加えられる応力が緩和され、被覆部にクラックを生じさらには導電性金属部から被覆部が剥離する現象が軽減される。これにより、被覆部の機能が損なわれることなく保持され、高い電力取り出し効率（変換効率）を得ることができる。

[0026] まず、本実施の形態の第一の例に係る色素増感太陽電池について、図1の模式図を参照して説明する。

本実施の形態の第一の例に係る色素増感太陽電池10は、基板12と、基

板 1 2 上（図 1 では下方向。以下同じ。）に配置される色素を吸着した多孔質半導体層 1 4 と、多孔質半導体層 1 4 の透明基板 1 2 とは反対側の表面に配置される導電性金属層 1 6 と、基板 1 2 と対向して設けられる導電性基板 1 8 を備える。

導電性金属層 1 6 と導電性基板 1 8 の間には内部スペーサ 2 1（支持体）が設けられる。スペーサ 2 0 で密閉される色素増感太陽電池 1 0 の空間に電解質（電解液）2 2 が充填される。

基板 1 2 は、透明基板であり、基板 1 2 の側から入射光が色素増感太陽電池 1 0 のセル内に導入される。

多孔質半導体層 1 4 は、図 1 に示すように基板 1 2 と接触して配置されてもよく、また基板 1 2 と近接して配置されてもよい。

導電性金属層 1 6 は、外部電極 2 6 に電氣的に接続される。なお、外部電極 2 6 は、基板 1 2 とは独立して適宜の位置に設けてもよい。

導電性基板 1 8 は、基板 2 8 と、基板 2 8 上に形成される透明導電膜 3 0 と、透明導電膜 3 0 上に形成される触媒膜（触媒層）3 2 で構成される。ただし、これに限らず、通常採用される適宜の構成としてもよい。

内部スペーサ 2 1 は、導電性金属層 1 6 および導電性基板 1 8 の間の電氣的絶縁をより確実に行うために設けるものである。内部スペーサ 2 1 は、例えばジルコニア材料で形成した直径が  $20\ \mu\text{m}$  程度の球状物や電解液に対し不溶性の樹脂製あるいはガラス製の不織布等を用いることができる。ただし、スペーサ 2 0 により導電性金属層 1 6 および導電性基板 1 8 を確実に離間配置させて絶縁する限り、内部スペーサ 2 1 は必ずしも設ける必要はない。

[0027] 基板 1 2 および基板 2 8 は、例えば、ガラス板であってもよくあるいはプラスチック板であってもよい。プラスチック板を用いる場合、例えば、PET、PEN、ポリイミド、硬化アクリル樹脂、硬化エポキシ樹脂、硬化シリコーン樹脂、各種エンジニアリングプラスチック、メタセシス重合で得られる環状ポリマ等が挙げられる。

透明導電膜 3 0 は、例えば、ITO（スズをドーパしたインジウム膜）で



あってもよく、またFTO（フッ素をドーブした酸化スズ膜）であってもよく、あるいはまたSnO<sub>2</sub>膜であってもよい。

触媒膜32は、白金膜や良導電性炭素等を用いることができる。

[0028] 多孔質半導体層14は、300℃以上の温度で焼成されたものであり、より好ましくは450℃以上の温度で焼成されたものである。一方、焼成温度の上限は特にないが、多孔質半導体層14の材料の融点よりは十分に低い温度とし、より好ましくは550℃以下の温度とする。

多孔質半導体層14は、その厚みを特に限定するものではないが、好ましくは、14μm以上の厚みとする。

[0029] 多孔質半導体層14に吸着させる色素は、多孔質半導体層14を形成する半導体材料に吸着させる色素であり、400nm~1000nmの波長に吸収を持つものである。このような色素として、例えば、COOH基を有する、ルテニウム色素、フタロシアニン色素などの金属錯体、シアニン色素などの有機色素を挙げることができる。多孔質半導体層14には光吸収領域が異なる色素が複数混合されて吸着されてもよいし、異なる色素が層状に複数吸着されてもよい。

[0030] 電解質22は、ヨウ素、リチウムイオン、イオン液体、テブチルピリジン等を含むものであり、例えばヨウ素の場合、ヨウ化物イオンおよびヨウ素の組み合わせからなる酸化還元体を用いることができる。酸化還元体は、これを溶解可能な適宜の溶媒を含む。

[0031] 導電性金属層16は、多孔質半導体層14の基板12が設けられる側とは反対側に配置される集電部である。導電性金属層16は、図2に示すように、導電性金属部17と、導電性金属部17に被覆される被覆部19で構成される。被覆部19は内層19aと外層19bで構成される。導電性金属層16は、多孔質半導体層14に電解質22が自在に流通するための無数の孔24が導電性金属部17に形成されている。

図2に示す導電性金属部17はメッシュ部材である。被覆部19は、後述する成膜法によって導電性金属部17の全面を被覆しているが、これに限らず、導電性金属部17の耐食性強化をさほど要しない場合等には、必要に応

じて導電性金属部 17 の少なくとも多孔質半導体層 14 と接触する側を被覆すればよい。このことは、以下に説明する他の実施の形態においても同様である。

被覆部 19 は、導電性金属部 17 の側から多孔質半導体層 14 の側に向けて酸化度が高くなる傾斜組成構造を有する。この傾斜組成構造は、組成が連続的に変化するものであってもよく、また、組成が段階的（階段的）に変化するものであってもよい。すなわち、被覆部 19 は、単層構造として、成膜時に内側から外側に向けて徐々に酸化度を変化させたものであってもよい。また、2 以上の酸化度が異なる材料を用い、導電性金属部 17 の側の内層を酸化度が小さい材料で形成するとともに多孔質半導体層 14 の側の外層を酸化度が大きい材料で形成した、異種材料層からなる多層構造であってもよい。

図 2 の被覆部 19 の場合、内層 19 a に比べて外層 19 b の酸化度が高い。

導電性金属部 17 の厚みは、特に限定するものではなく例えば数十 nm ～数十  $\mu$ m 程度とすることができるが、低い電気抵抗（抵抗）を得る観点からは、数  $\mu$ m ～十  $\mu$ m 程度であることが適当であり、かつ十分である。

被覆部 19 の厚みは、特に限定するものではなく例えば数百 nm 程度とすることができるが、少なくとも 20 nm 以上であると、導電性金属層 16 から電解質 22 への逆電子移動を防止し、かつ導電性金属部 17 との熱膨張係数との違いを緩和できる点で、より好ましい。

[0032] 導電性金属部 17 は、適度の導電性を有するものである限り、適宜の金属を選定して用いることができ、例えば、Ti、Pt、Au、Ag 等の金属、その合金類および金属酸化物等の金属化合物や、ステンレス、鉄、銅、アルミ、スズ等を用いることができる。これらのうち、材料の低コスト化およびより高い導電性を得る観点からは、ステンレスを用いることがより好ましい。

被覆部 19 は、耐食性金属を用いることが好ましく、Ti、W、Ni、P

t およびAuからなる群から選ばれる1種または2種以上の耐食性金属材料の酸化物であることがより好ましい。

[0033] 図2の導電性金属層16に代えて、図3に示すような導電性金属部17aを有する導電性金属層16aを用いてもよい。

導電性金属層16aは、例えば予め孔あけ加工したシート状の導電性金属部17aを用い、この導電性金属部17aに被覆部19を被覆したものである。この場合、所望の寸法、形状および配列の孔を形成することができる。

[0034] 上記のように構成される本実施の形態の第一の例に係る色素増感太陽電池10は、被覆部19が導電性金属部17、17aの側から多孔質半導体層14の側に向けて酸化度が高くなる傾斜組成構造を有することにより、導電性金属部17の側から多孔質半導体層14の側に向けて熱膨張率が低くなる傾斜組成構造を有する。すなわち、被覆部19の内層19aは導電性金属部17に近い高い熱膨張率を有し、被覆部19の外層19bは多孔質半導体層14に近い低い熱膨張率を有する。

なお、導電性金属部17の側から多孔質半導体層14の側に向けて熱膨張率が低くなる被覆部19の傾斜組成構造は、例えば2以上の熱膨張率が異なる材料を用い、導電性金属部17の側を熱膨張率が大きい材料で形成するとともに多孔質半導体層14の側を熱膨張率が小さい材料で形成することによっても得ることができる。

これにより、色素増感太陽電池10は、製造時の過酷な温度変化によって被覆部にクラックを生じさらには導電性金属部から被覆部が剥離する現象や導電性金属被覆部と多孔質半導体層が分離する現象が軽減されることで、被覆部の機能が損なわれることなく保持されるとともに多孔質半導体層と導電性金属層の良好な密着性が保持され、高い電力取り出し効率を得ることができる。

また、通常、基板12上に配置したチタニアペーストを焼成して多孔質半導体層14を形成するプロセスを採用するため、例えば450℃を超える高温に耐えるために基板12としてガラス基板を用いる必要がある。これに対

して、色素増感太陽電池 10 は、多孔質半導体層 14 を載置した導電性金属層 16、16a をセル組み立て時に基板 12 と接合することができ、これにより、基板 12 として、フレキシブルなプラスチック材料を用いることができる。

また、色素増感太陽電池 10 は、導電性金属層 16 を介して多孔質半導体層 14 内を電子が容易に移動し、さらにまた、導電性金属層 16 と電解質 22 の界面での逆電子移動が起こりにくい。

また、色素増感太陽電池 10 は、透明導電膜付きのガラス基板を用いないため、安価な基板 12 を用いることができる。

また、色素増感太陽電池 10 は、被覆部の材料を適宜選択し、あるいは成膜条件を調整することにより、被覆部と多孔質半導体層とのより良好な密着性を得ることができる。

また、色素増感太陽電池 10 は、導電性金属層 16 にチタニアペーストを塗布、焼成して得られる多孔質半導体層 14 付き導電性金属層 16 を、例えば Ti 箔からなる導電性基板 18 とプラスチックシートからなる基板 12 で挟んで製造することができるため、いわゆるロール・ツー・ロール方式を採用して安価に大量生産することが可能である。

[0035] つぎに、本実施の形態の第二の例に係る色素増感太陽電池について、図 4 の模式図を参照して説明する。

本実施の形態の第二の例に係る色素増感太陽電池 10a は、おおよその構成は色素増感太陽電池 10 と同様であるため、重複する構成要素についての説明は省略する。また、作用効果についても以下に格別に言及するもの以外は色素増感太陽電池 10 と同様であるため、重複する作用効果の説明は省略する。

[0036] 色素増感太陽電池 10a は、太陽電池セル組み立てに先立ち基板 12a と導電性金属層（以下、参照番号 23 で示す。）を一体的に設けて構成部材点数を減らすことができるように、対極である導電性基板 18 の側から入射光をセル内へ導入する点が、色素増感太陽電池 10 と大きく異なる。

上記の構造を実現するために、導電性基板 18 として透明基板が用いられる。なお、基板 12 a は、透明基板であってもよく、また、不透明基板であってもよい。導電性金属層 23 は、基板 12 a の表面に設けられる集電部であり、基板 12 a に接する側にシート状の導電性金属部 23 a が設けられ、さらに導電性金属部 23 a を被覆してシート状の被覆部 23 b が設けられる。

導電性金属層 23 に一定の剛性がある限り、基板 12 a を省略することも可能である。また、基板 12 a の存在を前提として、導電性金属部 23 a としてメッシュ部材を用いることを排除するものではない。

[0037] つぎに、上記本実施の形態の各例の色素増感太陽電池を好適に製造することができる、本実施の形態の色素増感太陽電池の製造方法について、図 5 および図 6 の模式図を参照して説明する。

[0038] 色素増感太陽電池 10 を例にとって、製造方法を説明する。

導電性金属層の導電性金属部 17 は、図 2 のメッシュ部材（金網）を用いる。なお、導電性金属層として図 3 の孔あきシート状の導電性金属層を用いる場合も、以下の工程に変わりはない。説明の都合上、導電性金属層の作製工程については後述するものとし、作製した導電性金属層を用いて色素増感太陽電池セルを作製する工程について、先に説明する。この工程は、従来の色素増感太陽電池セルを作製する工程と変わらない。

[0039] 図 5 に示すように、作製した導電性金属層 16 の上に例えばチタニアペー  
ストを塗布し、例えば 450℃の温度で焼成して、導電性金属層 16 上に多  
孔質半導体層 14 を形成する。

ついで、色素溶液に多孔質半導体層 14 付き導電性金属層 16 を例えば 4  
8 時間含浸して、多孔質半導体層 14 に色素を付着させる。

[0040] ついで、図 6 に示すように、別途作製した、透明導電膜および触媒膜付き  
の基板からなる導電性基板 18 と、同じく別途作製した基板 12 とで色素を  
付着した多孔質半導体層 14 付き導電性金属層 16 を挟み込むようにして、  
図示しないスペーサを用いてセルを組み立て、電解液をセル内に注入して色

素増感太陽電池セルを作製する。なお、この場合、電解液を含浸した多孔質プラスチックシートを、色素を付着した多孔質半導体層 14 付き導電性金属層 16 と導電性基板 18 の間に配置する構成とすると、セル完成後に電解液をセル内に注入する工程が省略され、前記したロール・ツー・ロール方式を採用するうえで好適である。

なお、色素増感太陽電池 10a を作製する場合は、図 7 に示すように、基板 12 上に薄膜技術によってシート状の導電性金属層 16 を形成して導電性金属層 16 付きの基板 12 を作製し、ついで、導電性金属層 16 付きの基板 12 上に例えばチタニアペーストを塗布し、例えば 450°C の温度で焼成して、導電性金属層 16 上に多孔質半導体層 14 を形成する点以外は、上記の製造方法と同様である。ここで、図 7 では、図示の便宜上、導電性金属層 16 と基板 12 を分離して表示しているが、実際には導電性金属層 16 が基板 12 に密着して形成されることは上記したとおりである。

[0041] つぎに、導電性金属層の作製方法について説明する。

[0042] 色素増感太陽電池 10 の場合、メッシュ部材等の導電性金属部に O、N、S、P、B および C からなる群から選ばれる 1 種または 2 種以上の元素を含む化合物を少量導入しながら薄膜技術により被覆部の原料金属を成膜することにより、酸化度、言い換えれば熱膨張率の傾斜組成構造を有する被覆部を導電性金属部上に形成する。導入する元素は、O または N であると、より好ましい。

一方、色素増感太陽電池 10a の場合、基板上に導電性金属部であるシート状の導電膜を成膜し、ついで、上記の方法と同様にして、導電膜上にシート状の被覆部を形成する。

また、先に説明したように、2 以上の熱膨張率が異なる材料を用いて傾斜組成構造を形成してもよく、さらにまた、同一材料を用いて異なる成膜方法で二段階以上の成膜を行うことで、2 以上の熱膨張率が異なる層を形成してもよい。

例えば Ti を原料金属として成膜する場合、多孔質半導体層 14 の側の被

覆部部分を高い酸化度のTiO<sub>2</sub>に近い組織とすることで、多孔質半導体層14の熱膨張率 $5 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ に近い熱膨張率とし、一方、導電性金属部17の側の被覆部部分を低い酸化度のTiに近い組織とすることで、 $8.4 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ に近い熱膨張率とすることができる。

なお、必要に応じて熱膨張率および酸化度の値を測定するには、適宜の方法を用いることができる。

酸化度については、例えばオージェ電子分光法（走査型オージェ電子分光分析装置ULVAC PHI-700）を使用し、標準物質である金属および酸素のピーク強度と、サンプルのピーク強度の比から酸化度を算出することができる。

熱膨張率については、例えば酸化度の測定により求められた酸化度に対応する熱膨張率を、金属便覧第5版（丸善）等に記載されている値から算出することができる。

[0043] 被覆部を形成する際の薄膜技術は、特に限定するものではないが、好ましくは、スパッタ法または真空蒸着法を用いる。

このとき、これらのうちのいずれか一方の方法のみを用いて、傾斜組成構造を有する被覆部を形成することができる。好ましくは、スパッタ法により導電性金属部の表面にスパッタ層を形成する段階とスパッタ層の表面に真空蒸着法により蒸着層を形成する段階を含む。

スパッタ法により形成される被覆部の内層の微粒子金属の集合体に比べて真空蒸着法により形成される外層の微粒子金属の集合体は、微粒子金属のサイズが小さい。このことも一因となって、大きな組成変化をもった傾斜組成構造が好適に形成されるものと考えられる。また、蒸着層は、その後の焼成時に膜厚が大きく増加しており、このことは、焼成時に蒸着層内の酸化が十分に進行していること、および焼成時に蒸着層にクラックが入ることを軽減することに寄与していることを示すものと考えられる。

真空蒸着法は、アークプラズマ蒸着法（プラズマアークデポジション法）または真空アーク蒸着法であると、平坦性に優れ、また、より緻密な被覆部を得ることができて、より好ましい。

[0044] 図8に、450°Cで30分焼成した後の被覆部となる層のSEM表面観察結果を示す。図8中、(a)は従来技術の塗布法により、(b)は本実施の形態のスパッタ法により、(c)は本実施の形態のアーキプラズマ蒸着法により、それぞれ成膜したものである。なお、平坦性の一例として、(a)塗布法で成膜したものの表面粗さRaが5.28nm、(b)本実施の形態のスパッタ法で成膜したものの表面粗さRaが1.96nm、(c)本実施の形態のアーキプラズマ蒸着法で成膜したものの表面粗さRaが0.55nmという結果が得られた。

また、図示等を省略するが、SEM観察によれば、被覆部で被覆しないステンレスメッシュに多孔質半導体層を形成したものは、ステンレスメッシュに明瞭なクラックが生じ、塗布法で形成した被覆部で被覆したステンレスメッシュに多孔質半導体層を形成したものは、被覆部あるいはステンレスメッシュにクラックが観察されるとともに多孔質半導体層のムラが観察され、本実施の形態のスパッタ法およびアーキプラズマ蒸着法で積層形成した被覆部で被覆したステンレスメッシュに多孔質半導体層を形成したものは、クラックが見られず、多孔質半導体層が均一にステンレスメッシュ上に形成されることが観察された。

また、データを省略するが、接触角を測定したところ、塗布法で形成した被覆部で被覆したステンレスメッシュに比べて本実施の形態のスパッタ法およびアーキプラズマ蒸着法で積層形成した被覆部で被覆したステンレスメッシュは大きな値が得られた。

## 実施例

[0045] 実施例および比較例を挙げて、本発明をさらに説明する。なお、本発明は、以下に説明する実施例に限定されるものではない。

[0046] (使用したステンレスメッシュ)

NBC社製ステンレスメッシュ#500(線径0.025mm、目開き(開き目、空間目)0.026mm、空間率25.8%、厚み55μm、材質SUS316)を使用した。



## [0047] (実施例 1)

40mm×50mmのステンレスメッシュの両面に、原料金属としてTiを用い、スパッタ法により、出力250Wで50分間処理して膜厚200nmのスパッタ膜を形成した。このとき、チャンバー内圧 $2.0 \times 10^{-4}$ Paの成膜装置に酸素ガスを少量導入、流通させて、チャンバー内圧を $4.0 \times 10^{-4}$ Paに保持した。

成膜したステンレスメッシュを20mm×25mmにカットした後、Solaronix SA社製スクリーンプリント用TiO<sub>2</sub>ペースト(Ti-Nanoxide D/SP)をメタルマスク(20mm×5mm)を用い、スキージ法で塗布した。その後、電気炉で450°Cの温度で30分間焼成した。冷却後、色素(N719)溶液へ48時間浸漬し、ついで、アセトニトリルとt-ブチルアルコールの混合溶液(1:1(v/V))で十分にリンスした後、25mm×5mmにカットして、色素の付着した多孔質半導体層が載置された導電性金属層を得た。

一方、15mm×10mmにカットした日本板硝子社製ポリエチレン多孔質フィルム(膜厚40μm、空間率80%)に有機溶媒系電解液(LiI 500mM, I<sub>2</sub> 50mM, t-Bupy 580mM, MeEtImN(CN)<sub>2</sub> 600mM, in Acetonitrile)を浸漬させて多孔質フィルムを作製するとともに、白金スパッタTi対極(白金スパッタの出力200W/50min、Ti板厚み3mm)を作製した。

導電性金属層の多孔質半導体層が載置された側とは反対側に多孔質フィルムおよび白金スパッタ対極をこの順に重ね、26mm×10mmにカットしたMATSHNAMI社製マイクロスライドガラス(S1127, 厚み1.2mm)2枚で両側から挟みこんだ状態で、エポキシ樹脂で封止して太陽電池セルを得た。

得られた太陽電池セルの性能評価は、分光計器社製ソーラーシュミレーター(色素増感型分光感度測定装置KHP-1型)を用いて行った。

性能評価の結果を表1に示す。表1中、効率は変換効率を、FFはフィルファクターを、V<sub>oc</sub>は光開放電圧を、J<sub>sc</sub>は光短絡電流密度を、それぞれ示

す。なお、以下の他の実施例および比較例の性能評価の結果も同様に表 1 に示す。

[0048] (実施例 2)

スパッタ膜に代えてアークプラズマ蒸着法により形成したアークプラズマ膜でステンレスメッシュを被覆したほかは、実施例 1 と同様の方法で太陽電池セルを作製し、性能評価を行った。

アークプラズマ蒸着法は、酸素ガスを成膜装置のチャンバーに少量導入し、チャンバー内圧を  $4.0 \times 10^{-4} \text{ Pa}$  に保持しながら、2000 ショットで膜厚 100 nm のアークプラズマ膜を成膜した。

[0049] (実施例 3)

実施例 1, 2 の条件でステンレスメッシュをスパッタ膜で被覆し、さらにアークプラズマ膜で被覆したほかは、実施例 1 と同様の方法で太陽電池セルを作製し、性能評価を行った。

[0050] (実施例 4)

ステンレスメッシュに代えて、穴径 75  $\mu\text{m}$ 、穴間ピッチ 150  $\mu\text{m}$  の穴を NC ドリルで開けた膜厚 20  $\mu\text{m}$  の多孔 Ti 箔を使用し、アークプラズマ蒸着法により形成したアークプラズマ膜で多孔 Ti 箔を被覆したほかは、実施例 1 と同様の方法で太陽電池セルを作製し、性能評価を行った。

[0051] (実施例 5)

40 mm  $\times$  50 mm のステンレスメッシュの両面に、原料金属として W を用い、スパッタ法により、出力 200 W で 60 分間処理して膜厚 300 nm のスパッタ膜を形成した。このとき、チャンバー内圧  $2.5 \times 10^{-4} \text{ Pa}$  の成膜装置に酸素ガスを少量導入、流通させて、チャンバー内圧を  $4.0 \times 10^{-4} \text{ Pa}$  に保持した。

成膜したステンレスメッシュを 20 mm  $\times$  25 mm にカットした後、Solar onix SA 社製スクリーンプリント用 TiO<sub>2</sub> ペースト (Ti-Nanoxide D/SP) をメタルマスク (20 mm  $\times$  5 mm) を用い、スキージ法で塗布した。その後、電気炉で 450 °C の温度で 60 分間焼成した。冷却後、色素 (ブラックダイ

) 溶液へ24時間浸漬し、ついで、アセトニトリルとt-ブチルアルコールの混合溶液(1:0.9(v/V))で十分にリンスした後、25mm×5mmにカットして、色素の付着した多孔質半導体層が載置された導電性金属層を得た。

一方、15mm×10mmにカットした日本板硝子社製ポリエチレン多孔質フィルム(膜厚40μm、空間率80%)に有機溶媒系電解液(LiI 500mM, I<sub>2</sub> 50mM, t-Bupy 580mM, MeEtImN(CN)<sub>2</sub> 600mM, in Acetonitrile)を浸漬させて多孔質フィルムを作製するとともに、白金スパッタTi対極(白金スパッタの出力250W/50min、Ti板厚み4mm)を作製した。

導電性金属層の多孔質半導体層が載置された側とは反対側に多孔質フィルムおよび白金スパッタ対極をこの順に重ね、26mm×10mmにカットしたMATSHNAMI社製マイクロスライドガラス(S1127, 厚み1.2mm)2枚で両側から挟みこんだ状態で、エポキシ樹脂で封止して太陽電池セルを得た。

得られた太陽電池セルの性能評価は、実施例1と同様の方法で行った。

[0052] (比較例1)

成膜を行わないステンレスメッシュを用いたほかは、実施例1と同様の方法で太陽電池セルを作製し、性能評価を行った。

[0053] (比較例2)

ステンレスメッシュに塗布法により膜厚200nmのTiO<sub>2</sub>膜を被覆したほかは、実施例1と同様の方法で太陽電池セルを作製し、性能評価を行った。

[0054] (比較例3)

成膜を行わない多孔Ti箔をそのまま用いたほかは、実施例4と同様の方法で太陽電池セルを作製し、性能評価を行った。

[0055]

[表1]

	効率 (%)	FF	V <sub>OC</sub> (V)	J <sub>SC</sub> (mA/cm <sup>2</sup> )
実施例 1	3.85	0.59	0.75	8.75
実施例 2	3.42	0.52	0.67	9.82
実施例 3	4.68	0.65	0.74	9.8
比較例 1	2.21	0.51	0.65	6.74
比較例 2	2.87	0.52	0.66	8.43
実施例 4	4.60	0.70	0.82	8.1
比較例 3	3.60	0.63	0.78	7.4
実施例 5	4.50	0.65	0.75	9.25

### 符号の説明

- [0056] 10 色素増感太陽電池
- 12、28 基板
- 14 多孔質半導体層
- 16、16a、23 導電性金属層
- 17、17a、23a 導電性金属部
- 18 導電性基板
- 19、23b 被覆部
- 19a 内層
- 19b 外層
- 21 内部スペーサ
- 20 スペーサ
- 22 電解質
- 23a 導電性金属部
- 26 外部電極
- 30 透明導電膜
- 32 触媒膜

## 請求の範囲

- [請求項1] 基板と、カソード極となる導電性基板と、該基板と該導電性基板の間に、該基板に近接してまたは接触して配置され色素を吸着した多孔質半導体層と、該多孔質半導体層と接触して配置されアノード極となる導電性金属層を備え、該基板および該導電性基板のうちの少なくともいずれか一方が透明基板であり、電解質が封止されてなる色素増感太陽電池であって、
- 該導電性金属層が、導電性金属部と、該導電性金属部の少なくとも該多孔質半導体層と接触する側に被覆される被覆部で構成され、
- 該被覆部が、該導電性金属部の側から該多孔質半導体層の側に向けて熱膨張率が低くなる傾斜組成構造を有することを特徴とする色素増感太陽電池。
- [請求項2] 前記被覆部が、前記導電性金属部の側から前記多孔質半導体層の側に向けて酸化度が高くなる傾斜組成構造を有することを特徴とする請求項1記載の色素増感太陽電池。
- [請求項3] 前記被覆部が、Ti、W、Ni、PtおよびAuからなる群から選ばれる1種または2種以上の耐食性金属材料の酸化物で形成されてなることを特徴とする請求項2記載の色素増感太陽電池。
- [請求項4] 前記導電性金属層が、前記多孔質半導体層の前記基板が設けられる側とは反対側に配置される集電部であり、該多孔質半導体層に前記電解質が自在に流通するための無数の孔が前記導電性金属部に形成されてなるとともに、外部電極に電氣的に接続されてなり、前記基板が透明基板であることを特徴とする請求項2または3に記載の色素増感太陽電池。
- [請求項5] 前記導電性金属層の前記導電性金属部がメッシュ部材であることを特徴とする請求項4記載の色素増感太陽電池。
- [請求項6] 前記導電性金属層が、前記基板の表面に設けられる集電部であり、該基板に接する側に前記導電性金属部が設けられおよび該導電性金属

部を被覆して前記被覆部が設けられるとともに、前記導電性基板が透明基板であることを特徴とする請求項2または3に記載の色素増感太陽電池。

[請求項7] 前記被覆部が、前記導電性金属部の側から前記多孔質半導体層の側に向けて熱膨張率が低くなる2以上の異種材料の積層構造であることを特徴とする請求項1記載の色素増感太陽電池。

[請求項8] 請求項2～6のいずれか1項に記載の色素増感太陽電池の製造方法であって、

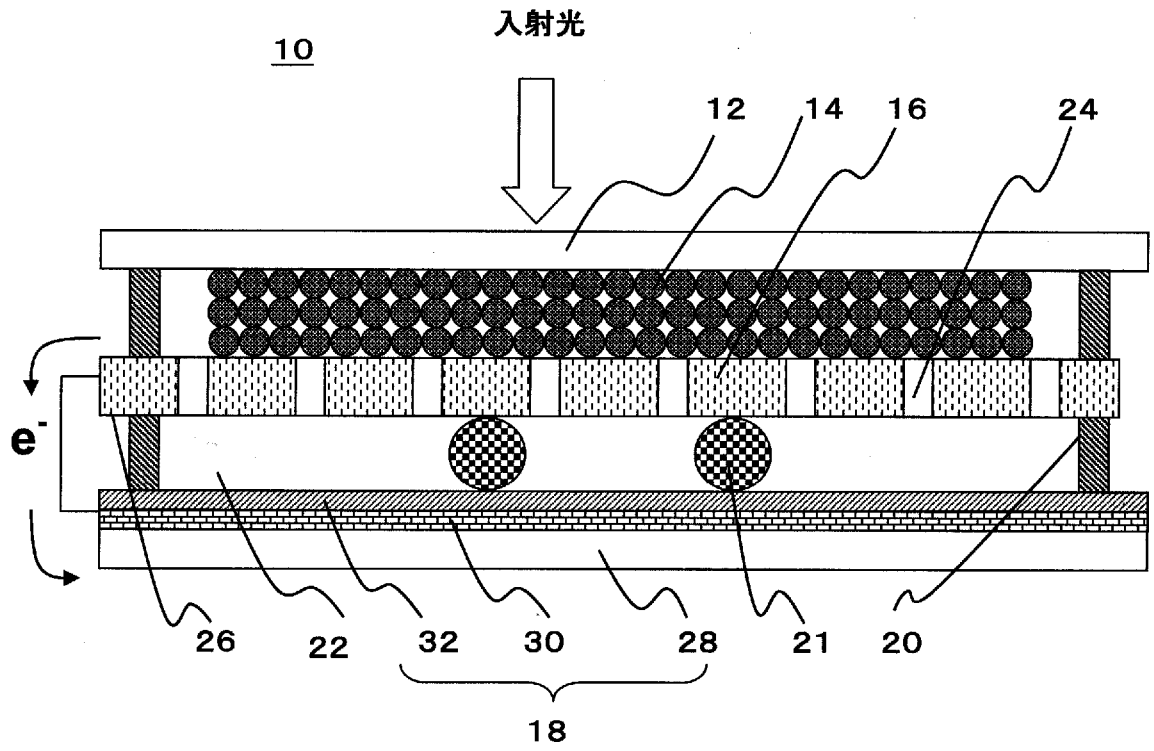
予め形成した導電性金属部に被覆部を被覆形成する工程において、O、N、S、P、BおよびCからなる群から選ばれる1種または2種以上の元素を含む化合物を少量導入しながら薄膜技術により導電性金属被覆の原料金属を成膜することにより傾斜組成構造を形成することを特徴とする色素増感太陽電池の製造方法。

[請求項9] 請求項2～6のいずれか1項に記載の色素増感太陽電池の製造方法であって、

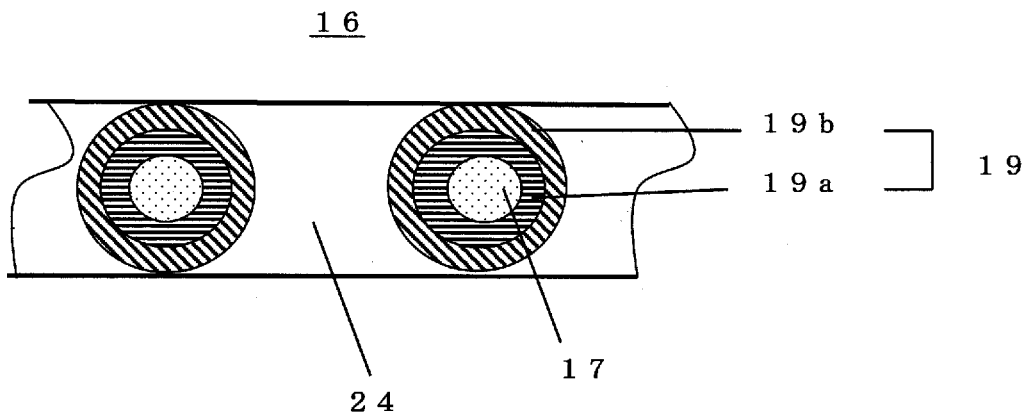
予め形成した導電性金属部に被覆部を被覆形成する工程において、スパッタ法によりスパッタ層を形成する段階と該スパッタ層の表面に真空蒸着法により蒸着層を形成する段階を含むことにより傾斜組成構造を形成することを特徴とする色素増感太陽電池の製造方法。

[請求項10] 前記真空蒸着法が、アークプラズマ蒸着法または真空アーク蒸着法であることを特徴とする請求項9記載の色素増感太陽電池の製造方法。

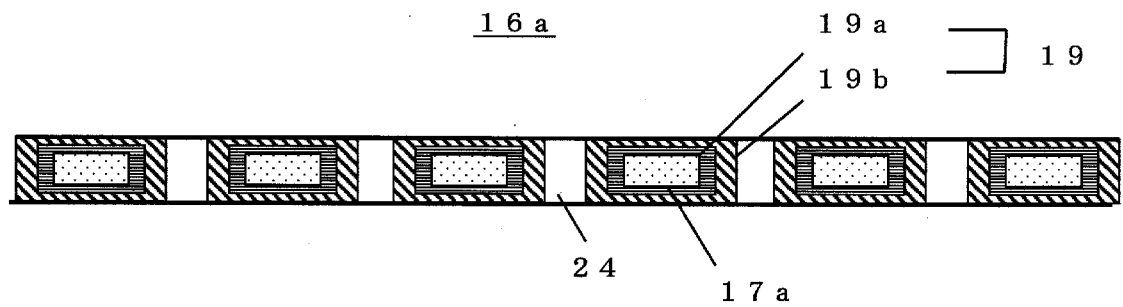
[図1]



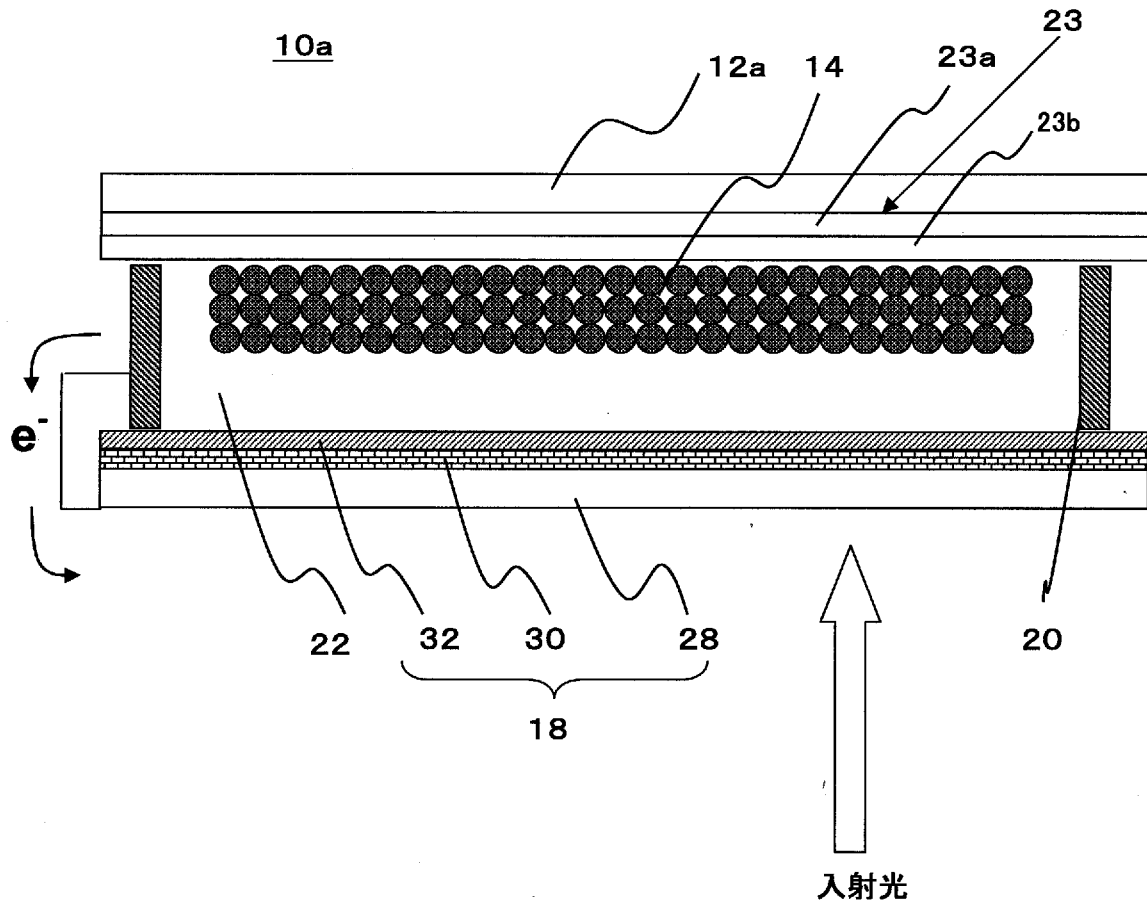
[図2]



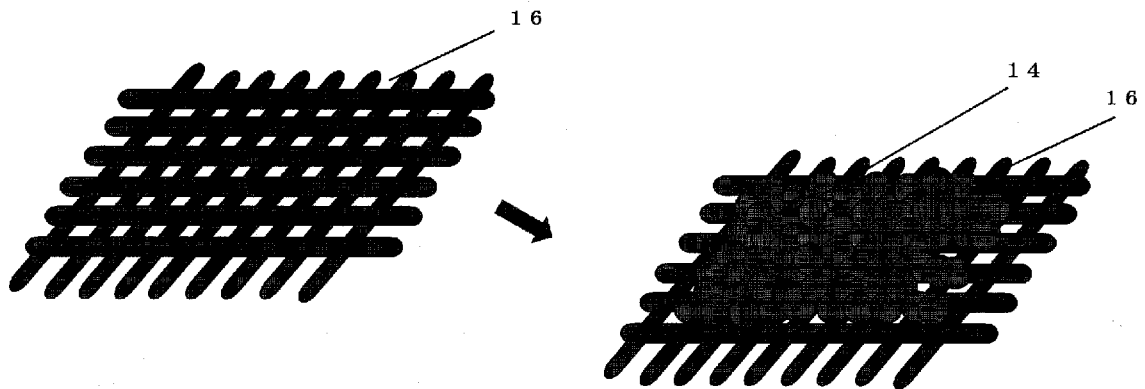
[図3]



[图4]

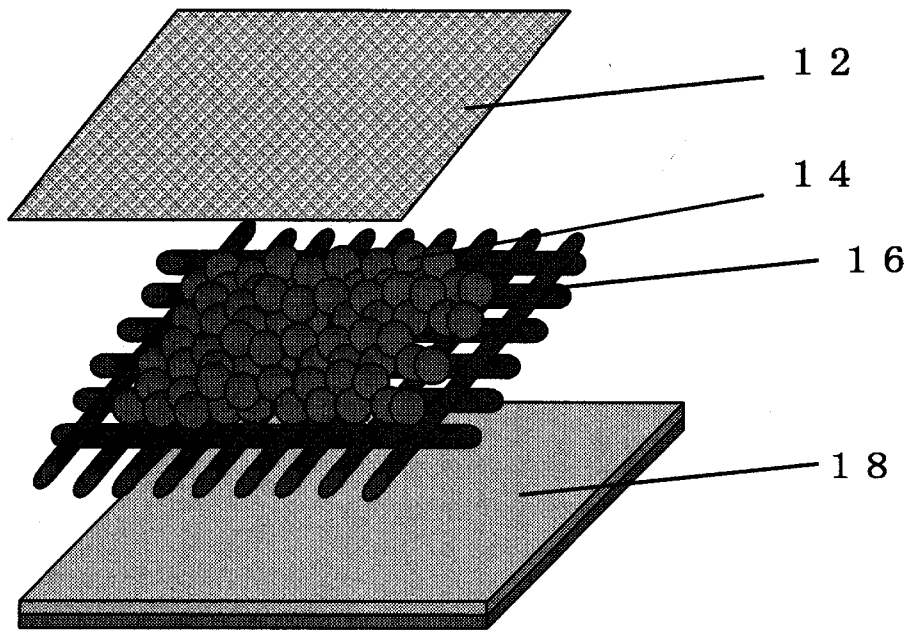


[图5]

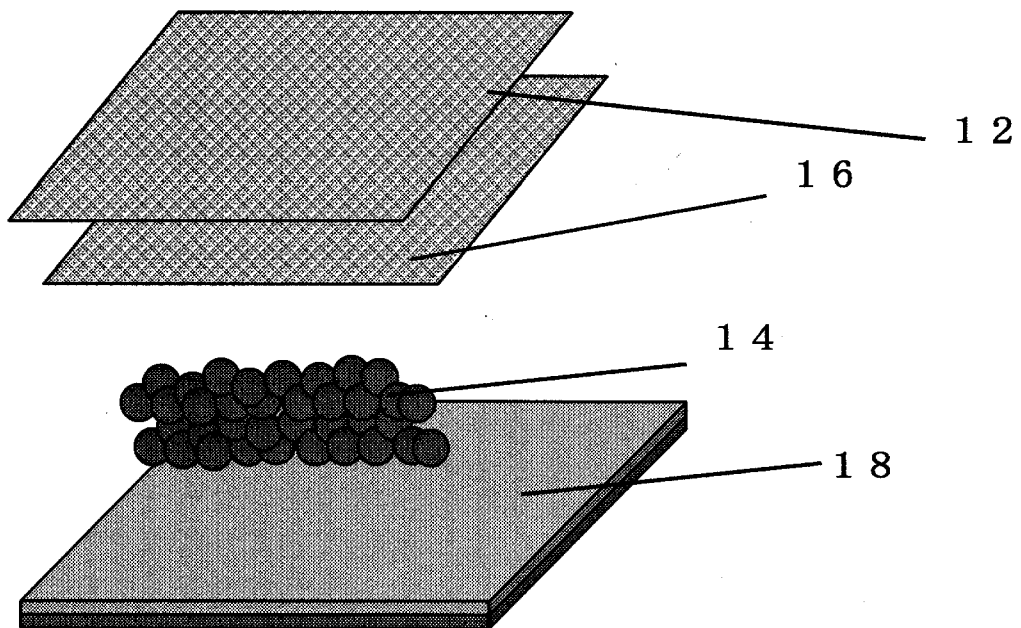




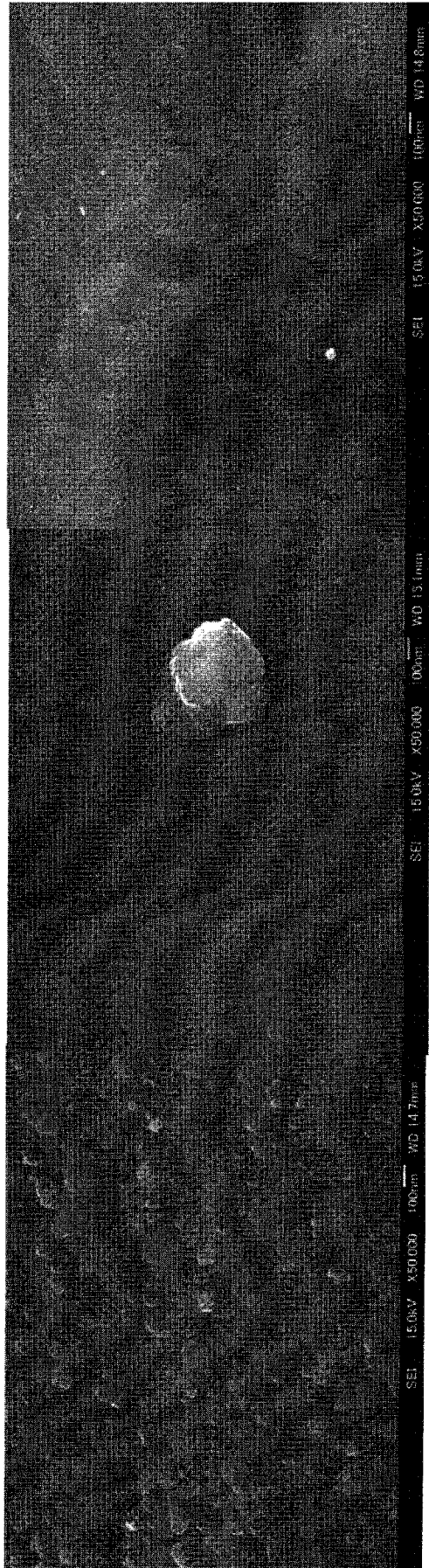
[图6]



[图7]



[8]



(a)

(b)

(c)

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

International application No. PCT/JP2009/004047
--

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
H01M14/00(2006.01)i, H01L31/04(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
H01M14/00, H01L31/04

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2009
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2009	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2009

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X A	JP 2006-59680 A (Fujikura Ltd.), 02 March, 2006 (02.03.06), Claims; Par. Nos. [0023] to [0024]; Figs. 1 to 7 (Family: none)	1, 3, 6-10 2, 4-5
A	JP 2008-192427 A (Fujikura Ltd.), 21 August, 2008 (21.08.08), Claims (Family: none)	1-10
A	JP 2007-42366 A (Fujikura Ltd.), 15 February, 2007 (15.02.07), Claims & US 2008/0169022 A1 & EP 1919023 A1 & WO 2007/015342 A1	1-10

Further documents are listed in the continuation of Box C.       See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search 30 September, 2009 (30.09.09)	Date of mailing of the international search report 13 October, 2009 (13.10.09)
--	---

Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

International application No.

PCT/JP2009/004047

**Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)**

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1.  Claims Nos.:  
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
  
2.  Claims Nos.:  
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
  
3.  Claims Nos.:  
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

**Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)**

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

There must exist a special technical feature that links a group of inventions to form a single general inventive concept to have the group of inventions in claims satisfy the requirement of unity of invention. The group of inventions in claims 1-10 are linked merely by the feature in claim 1. The feature, however, cannot be a special technical feature since it is disclosed in prior art documents, for instance, JP 2006-59680 A (Fujikura Ltd.), 2 March, 2006 (02.03.06). (Continued to extra sheet.)

1.  As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2.  As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of additional fees.
3.  As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
  
4.  No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

**Remark on Protest**  
the

- The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, payment of a protest fee.
- The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest fee was not paid within the time limit specified in the invitation.
- No protest accompanied the payment of additional search fees.

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

International application No.

PCT/JP2009/004047

Continuation of Box No.III of continuation of first sheet(2)

Consequently, there is no special technical feature among a group of inventions in claims 1-10 so as to link them to form a single general inventive concept. Therefore, it is clear that the group of inventions in claims 1-10 do not satisfy the requirement of unity of invention.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl. H01M14/00(2006.01)i, H01L31/04(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl. H01M14/00, H01L31/04

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2009年
日本国実用新案登録公報	1996-2009年
日本国登録実用新案公報	1994-2009年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X	JP 2006-59680 A (株式会社フジクラ) 2006.03.02, 【特許請求の範囲】、【0023】 - 【0024】、【図1】 - 【図7】 (ファミリーなし)	1、3、6-10
A		2、4-5
A	JP 2008-192427 A (株式会社フジクラ) 2008.08.21, 【特許請求の範囲】 (ファミリーなし)	1-10
A	JP 2007-42366 A (株式会社フジクラ) 2007.02.15, 【特許請求の範囲】 & US 2008/0169022 A1 & EP 1919023 A1 & WO 2007/015342 A1	1-10

☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

\* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの  
 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの  
 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)  
 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献  
 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献  
 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの  
 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの  
 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの  
 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

30.09.2009

国際調査報告の発送日

13.10.2009

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)  
 郵便番号100-8915  
 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

前田 寛之

4X

2930

電話番号 03-3581-1101 内線 3477

## 第II欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見（第1ページの2の続き）

法第8条第3項（PCT17条(2)(a)）の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。

1.  請求項 \_\_\_\_\_ は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。つまり、
  
2.  請求項 \_\_\_\_\_ は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
  
3.  請求項 \_\_\_\_\_ は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に従って記載されていない。

## 第III欄 発明の単一性が欠如しているときの意見（第1ページの3の続き）

次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるところの国際調査機関は認めた。

請求の範囲に記載されている一群の発明が単一性の要件を満たすには、その一群の発明を単一の一般的発明概念を形成するように連関させるための、特別な技術的特徴の存在が必要であるところ、請求項1-10に係る一群の発明は、請求項1に記載されている事項でのみ連関しているが、この事項は、先行技術文献、例えば、JP 2006-59680 A（株式会社フジクラ）2006.03.02に記載されているため、特別な技術的特徴とはなり得ない。

そうすると、請求項1-10に係る一群の発明の間には、単一の一般的発明概念を形成するように連関させるための、特別な技術的特徴は存在しないこととなる。そのため、請求項1-10に係る一群の発明が発明の単一性の要件を満たしていないことは明らかである。

1.  出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求項について作成した。
2.  追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求項について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3.  出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求項のみについて作成した。
4.  出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求項について作成した。

## 追加調査手数料の異議の申立てに関する注意

- 追加調査手数料及び、該当する場合には、異議申立手数料の納付と共に、出願人から異議申立てがあった。
- 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあったが、異議申立手数料が納付命令書に示した期間内に支払われなかった。
- 追加調査手数料の納付はあったが、異議申立てはなかった。